**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение**

**высшего образования**   
**"Национальный исследовательский университет**   
**"Высшая школа экономики"**

Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова НИУ ВШЭ

**Курс: Электротехника, электроника и метрология**

**Департамент электронной инженерии**

**ОТЧЕТ**

**по домашнему заданию № 2**

**Тема**: Проектирование фрагмента интегральной микросхемы.

**Вариант**: 19-1, **Бригада**: 5-6

**Студент: Хромов Григорий Александрович**

**Группа: БИВ175**

**Преподаватель: Исмаил-Заде Мамед Рашидович**

**МОСКВА 2019**

Оглавление

# Описание таблицы истинности и принцип работы схемы на электрическом уровне

Рисунок 1. Схема КМОП xor

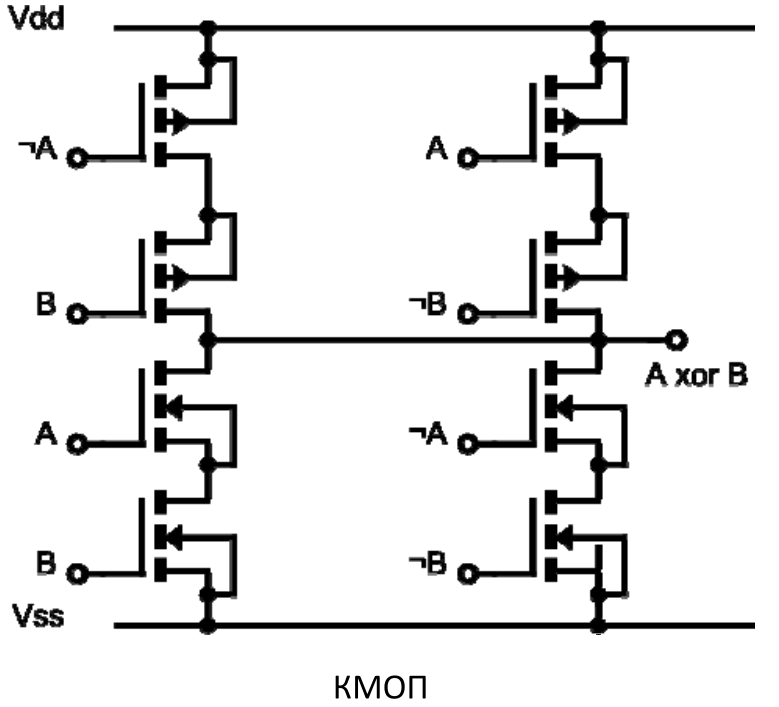


Таблица 1. Таблица истинности

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *A* | *B* |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Принцип работы на электрическом уровне:

На рисунках ниже (рис. 1-4) представлены схемы, где показаны состояния транзисторов («Х» – транзистор закрыт, «->» - транзистор открыт). При подаче на вход p-МОПТ, транзистор закрывается, а n-МОПТ открывается. При подаче на вход p-МОПТ, транзистор открывается, а n-МОПТ закрывается. , .

Фиолетовая стрелка показывает значение напряжения на выходе схемы.

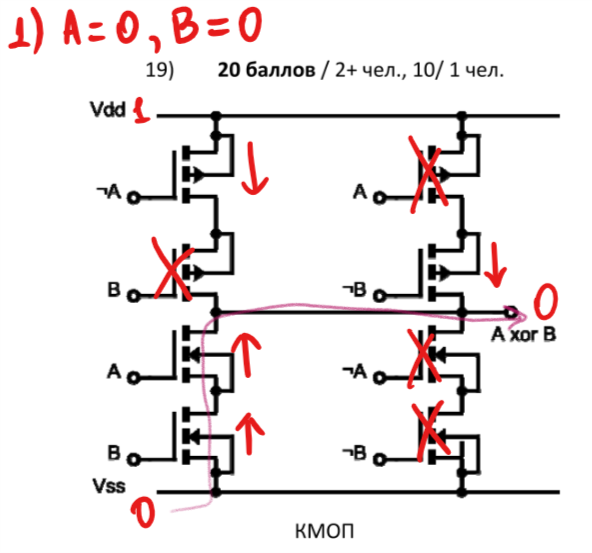


Рисунок 2. A = U\_лог^0, В = U\_лог^0

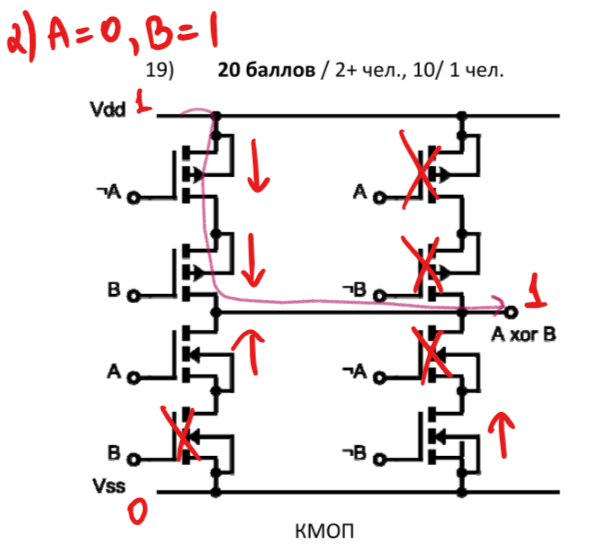


Рисунок 3. A = U\_лог^0, В = U\_лог^1

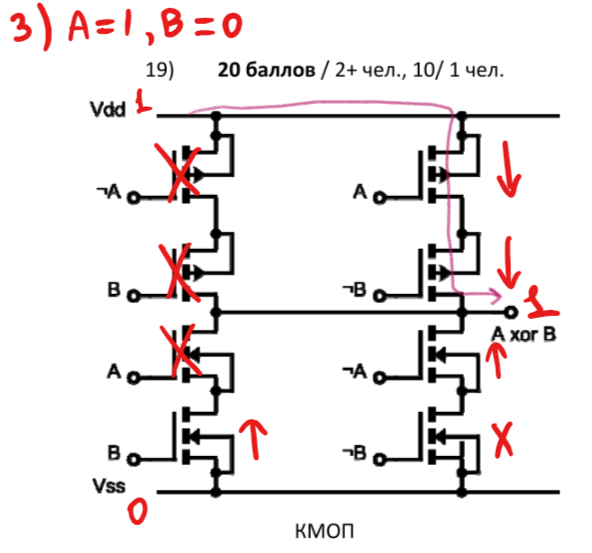


Рисунок 4. A = U\_лог^1, В = U\_лог^0

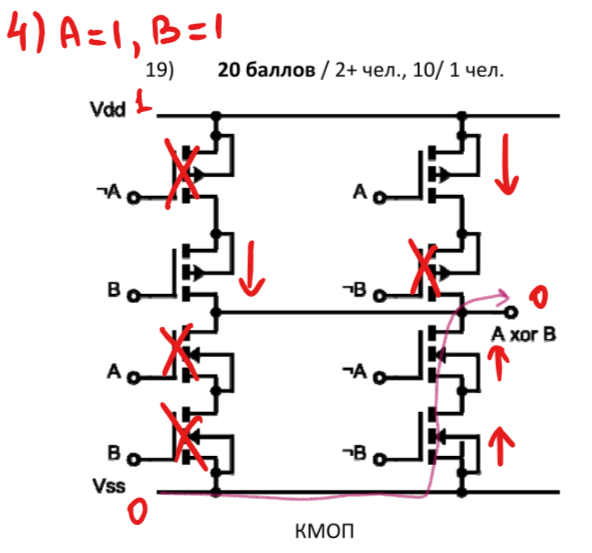


Рисунок 5. A = U\_лог^1, В = U\_лог^1

Выходное напряжение = ,

# Расчет параметров элементов схемы

Параметры схемы:

Таблица 2. Топологические нормы (правила проектирования)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметр | Описание | Значение |
|  | Минимальный топологический размер, мкм | 0,25 |
|  | Минимальный размер стороны контактного окна | 0,5·Δ |
|  | Минимальный размер фигуры в слое металла | 0,5·Δ |
|  | Минимальное перекрытие металлом контактного окна | 0,5·Δ |
|  | Минимальное расстояние от границ контактного окна до границ контактируемой области | 0,5·Δ |
|  | Минимальное расстояние между фигурами в слое металла | 0,5·Δ |
|  | Остальные топологические нормы | 0,5·Δ |

Таблица 3. Технологические и геометрические параметры МОП-транзисторов, значения которых необходимо выбрать для расчёта параметров SPICE-модели и топологии

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметр | Описание | Значение |
|  | Напряжение питания, В | 2,5 |
|  | Емкость межсоединения, пФ | 10 |
|  | Толщина подзатворного оксида, нм | 6 |
|  | Подвижность электронов, м2/(В·с) | 0,0317 |
|  | Подвижность дырок, м2/(В·с) | 0,0136 |
|  | Перекрытие затвором областей стока/истока, мкм | 0,25 |
|  | Глубина залегания p-n перехода исток-подложка и сток-подложка, нм | 100 |
|  | Длина канала, м | 1,0·Δ |
|  | Ширина канала, м | 0,5·Δ--- |
|  | Площадь истока, м2 | 0,5·Δ |
|  | Площадь стока, м2 | 0,5·Δ |
|  | Периметр истока, м | 0,5·Δ |
|  | Периметр стока, м | 0,5·Δ |